

[首页](#)[机构](#)[成果](#)[学者](#)

中国科学院机构知识库网格

Chinese Academy of Sciences Institutional Repositories Grid

[登录](#) [注册](#)

CAS IR Grid / 深圳先进技术研究院 / 中国科学院深圳先进技术研究院 / 先进院专利

埋入式薄膜电阻材料及其制备方法

文献类型: 专利

入库方式: OAI收割

来源: [深圳先进技术研究院](#)

浏览	下载	收藏
12	1	0

作者 孙蓉; 赖莉飞; 符显珠**发表日期** 2013-11-13**专利国别** 中国**专利号** 201310566007.5**专利类型** 发明**权利人** 中国科学院深圳先进技术研究院**授权日期** 2015-09-30**源URL** [<http://ir.siat.ac.cn:8080/handle/172644/8432>] **专题** 深圳先进技术研究院_先进院专利**作者单位** 2013-11-13**推荐引用方式** 孙蓉,赖莉飞,符显珠. 埋入式薄膜电阻材料及其制备方法. 201310566007.5 . 2013-11-13.**GB/T 7714**[其他版本](#)

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。

[» 欧盟学术资源开放存取平台](#) | [» CALIS高校机构知识库](#) | [» 台湾学术机构典藏](#) | [» 香港机构知识库整合系统](#) | [网站地图](#) | [意见反馈](#)

□ 版权所有 ©2023 中国科学院 - 运行维护: 中国科学院兰州文献情报中心/中国科学院西北生态环境资源研究院 - Powered by CSpace



0931-8270076 发送邮件

陇ICP备2021001824
号-8

甘公网安备 62010202001088号